PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-020294

(43) Date of publication of application: 23.01.1998

(51)Int.CI.

GO2F 1/1335 G02F 1/1335 3/00 G02B. **G02F** 1/136

(21)Application number: 08-173707

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

03.07.1996

(72)Inventor: HIKIBA MASAYUKI

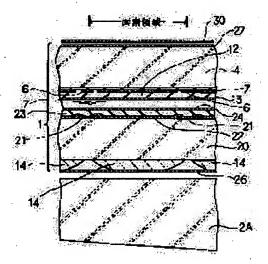
YAMAGUCHI SADAKO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To substantially improve numerical aperture in spite of the limit of fine working by forming a convex lens every pixel area on the surface on an opposite side to liquid crystal of a transparent base plate on the backlight side of a liquid crystal display panel.

SOLUTION: A microlens consisting of the convex lens 14 is formed in every pixel area on the surface on the side of the light transmission plate 2A of the transparent base plate positioned on the side of the backlight out of a pair of transparent base plates constituting the liquid crystal display panel 1. The lens 14 is formed to be optically separated from another adjacent convex lens. Thus, light from the backlight radiated to each pixel area of the panel 1 is condensed in each pixel area, and the condensed light reaches an absorber side as it is. Thus, the light from the backlight is effectively utilized whether the numerical aperture of each pixel area is large or small. Therefore, the same effect as the case the numerical aperture is substantially improved is obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other/than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-20294

(43)公開日 平成10年(1998)1月23日

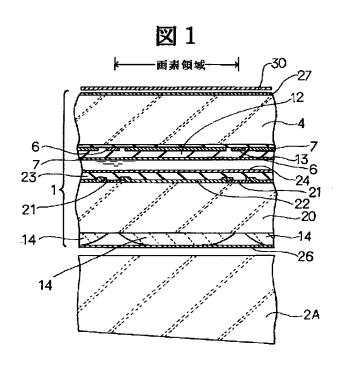
| G 0 2 F 1/1335 G 0 2 F 1/1335 5 1 0 5 1 0 5 1 0 G 0 2 B 3/00 A G 0 2 F 1/136 5 0 0 審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 8 (21) 出願番号 特願平8-173707 (71) 出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番・ (72) 発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72) 発明者 山口 禎子 | GO 2 F 1/1335 GO 2 F 1/1335 5 1 0 5 1 0 GO 2 B 3/00 A GO 2 F 1/136 5 0 0 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁))出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所電子デバイス事業部内 | | | | | | _ | | | |
|---|---|---------------------------|--------|-------------|---------------|---------|---------|--------------------|------|----------------|
| 510 510 G02B 3/00 G02B 3/00 A G02F 1/136 500 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全8 (21)出願番号 特願平8-173707 (22)出願日 平成8年(1996)7月3日 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | 510 | (51) Int.Cl. ⁶ | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | | | ł | 支術表示箇 |
| G02B 3/00 G02F 1/136 500 G02F 1/136 500 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全8 (21)出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | G 0 2 B 3/00 G 0 2 F 1/136 5 0 0 審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 8 頁) 出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所電子デバイス事業部内 | G02F | 1/1335 | | | G 0 2 F | 1/1335 | | | |
| G02F 1/136 500 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全8 (21)出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 (22)出願日 平成8年(1996)7月3日 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番: (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | GO2F 1/136 500 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁))出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所電子デバイス事業部内 | | | 510 | | | | 510 | | |
| 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 (21)出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番: (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁))出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 | G 0 2 B | 3/00 | | | G 0 2 B | 3/00 | | Α | |
| (21)出願番号 特願平8-173707 (71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 |)出願番号特願平8-173707(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デパイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デパイス事業部内 | G 0 2 F | 1/136 | 500 | | G 0 2 F | 1/136 | 500 | | |
| 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 | | | | | 審査請求 | え 未請求 | 請求項の数 6 | OL | (全 8 頁 |
| (22)出願日 平成8年(1996)7月3日 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | 決出顧日 平成8年(1996)7月3日 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 | (21) 出願番号 | | 特願平8-173707 | | (71)出願人 | 0000051 | 108 | | |
| (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | (72)発明者 引場 正行 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 | | | | | | 株式会 | 吐日立製作所 | | |
| 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 | (22) 出願日 | | 平成8年(1996)7 | 月3日 | | 東京都 | 千代田区神田駿 | 可台四门 | 「目6番地 |
| 製作所電子デパイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 | 製作所電子デバイス事業部内 (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日ゴ 製作所電子デバイス事業部内 | | | | | (72)発明者 | 引場 | E行 | | |
| (72)発明者 山口 禎子 | (72)発明者 山口 禎子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日ゴ 製作所電子デバイス事業部内 | | | | | | 千葉県 | 芝原市早野3300 7 | 野地 杉 | 大式会社日 3 |
| | 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内 | | | | | | 製作所 | 電子デバイス事 | 幹部内 | |
| 工機但本国市日麻2200番份 基子入外 | 製作所電子デパイス事業部内 | | | | | (72)発明者 | 计中心 | 填子 | | |
| T来朱汉原印平约5300世起 休以云社 | | | | | | | 千葉県 | 支原市早野33007 | 野地 杉 | 大式会社日 3 |
| 製作所電子デバイス事業部内 | (74)代理人 弁理士 秋田 収喜 | | | | | | 製作所 | 電子デバイス事業 | 幹部内 | |
| (74)代理人 弁理士 秋田 収喜 | | | | | | (74)代理人 | . 弁理士 | 秋田 収喜 | | |
| | | | | | | I . | | | | |

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 微細加工の限界等にも拘らず、実質的に開口率を大幅に向上させたことと同様の効果を得る。

【解決手段】 液晶を介して互いに対向配置される透明 基板と、その各画素領域ごとに該液晶の光透過率を制御できる手段とを備える液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの観察側とは反対の側に配置されて該液晶に光を 透過させるバックライトと、を備える液晶表示装置において、前記液晶表示パネルのバックライト側の透明基板の該液晶とは反対の側の面に、その各画素領域毎に凸レンズが形成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶を介して互いに対向配置される透明 基板と、その各画素領域ごとに該液晶の光透過率を制御 できる手段とを備える液晶表示パネルと、

この液晶表示パネルの観察側とは反対の側に配置されて 該液晶に光を透過させるバックライトと、を備える液晶 表示装置において、

前記液晶表示パネルのバックライト側の透明基板の該液 晶とは反対の側の面に、その各画素領域毎に凸レンズが 形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 凸レンズは、合成樹脂材で形成されてい ることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項3】 凸レンズは、各画素領域毎に形成された 島状の合成樹脂材を加熱処理をすることによって軟化さ せ、その際の表面張力によってほぼ半球状の形状となっ ていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項4】 液晶表示パネルの前記凸レンズが形成さ れた透明基板の面に偏光板が配置され、この偏光板は少 なくとも画素領域の集合で形成される表示部を回避させ て該透明基板に被着されていることを特徴とする請求項 20 1記載の液晶表示装置。

【請求項5】 液晶表示パネルは、その各画素領域ごと の液晶に透明基板とほぼ平行に発生させる電界によって その光透過率を制御させる液晶表示パネルであることを 特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項6】 液晶表示パネルは、その各画素領域ごと の液晶に透明基板とほぼ垂直に発生させる電界によって その光透過率を制御させる液晶表示パネルであって、そ の観察側の透明基板の液晶側とは反対の側の面に位相差 板が配置されていることを特徴とする請求項1記載の液 30 晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係 り、たとえばアクティブ・マトリックス型と称される液 晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は、通常、いわゆる液晶表 示パネルと、この液晶表示パネルの観察側とは反対側の 面に配置されたバックライトとを備えて構成されてい

【0003】アクティブ・マトリックス型の液晶表示装 置は、その液晶表示パネルにおいて、液晶を介して互い に対向配置される一対の透明基板のうちその一方の液晶 側の面に、まず、x方向に延在しy方向に並設されるゲ ート信号線と、このゲート信号線に絶縁されてy方向に 延在しx方向に並設されるドレイン信号線とを備え、こ れらゲート信号線およびドレイン信号線によって囲まれ た領域をそれぞれ画素領域としている。

【0004】そして、これら各画素領域には、ゲート信 50 【0013】このように構成した液晶表示装置におい

号線への走査信号の供給によってオンされる薄膜トラン ジスタと、このオンされた薄膜トランジスタを介してド レイン信号線へ供給された映像信号が印加される画素電 極(透明電極)とが備えられている。

【0005】一方、他方の透明基板の液晶側の面には、 各画素領域を共通にして形成された共通電極(透明電 極)が形成され、この共通電極と映像信号が印加された 前記画素電極との間に電界を生じせしめ、これら各電極 の間に介在された液晶の光透過率を変化せしめるように なっている。

【0006】これにより、液晶表示パネルを介して透過 される前記バックライトからの光によって、前記各信号 線に供給される走査信号および映像信号に応じて形成さ れる映像を観察者が認識できるようになっている。

【0007】この場合、ゲート信号線およびドレイン信 号線によって囲まれる画素領域それ自体の面積が小さい 場合、あるいは該画素領域内に形成される前記薄膜トラ ンジスタの占有面積が大きい場合には、該画素領域に照 射されるバックライトの光量に対して液晶を透過して観 察者側に至る光量が大幅に少なくなってしまう。

【0008】このことから、各画素領域において、それ 自体の面積を大きくしたり、あるいは、占有面積を小さ くして薄膜トランジスタを形成することによって、いわ ゆる画素の開口率を向上させる試みがなされている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかし、フォトリソグ ラフィ技術を用いた選択エッチングによる微細加工の限 界等から、該開口率を大幅に向上させることは極めて困 難となっている。

【0010】このため、液晶を透過する光を所定の量に するため、大電力用のパックライトを用い、該バックラ イトそれ自体から発生する光の量を大きくする構成とな っているのが現状となっている。

【0011】本発明は、このような事情に基づいてなさ れたものであり、その目的は、微細加工の限界等にも拘 らず、実質的に開口率を大幅に向上させたことと同様の 効果を得ることのできた液晶表示装置を提供することに ある。

[0012]

【課題を解決するための手段】このような目的を達成す るために、本発明は、基本的には、液晶を介して互いに 対向配置される透明基板と、その各画素領域ごとに該液 晶の光透過率を制御できる手段とを備える液晶表示パネ ルと、この液晶表示パネルの観察側とは反対の側に配置 されて該液晶に光を透過させるバックライトと、を備え る液晶表示装置において、前記液晶表示パネルのバック ライト側の透明基板の該液晶とは反対の側の面に、その 各画素領域毎に凸レンズが形成されていることを特徴と するものである。

て、その液晶表示パネルの各画素領域にそれぞれ照射さ れるバックライトの光は、該液晶表示パネルを構成する 透明基板に形成された凸レンズを介して画素領域内に集 光され、その集光された光はそのまま観察者側へ至るこ とになる。

【0014】このことは、各画素領域のいわゆる開口率 の大小に拘らず、バックライトからの光を有効に利用で きることを意味する。

【0015】したがって、実質的に開口率を大幅に向上 させたことと同様の効果を得ることができるようにな る。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置 の一実施例を図面を用いて説明する。

【0017】〔実施例1〕まず、液晶表示装置は、その 側面図である図2に示すように、少なくとも、液晶表示 パネル1があり、その背面にはバックライト2が配置さ れて構成されている。

【0018】液晶表示パネルは1、後に詳述するよう に、そのパネル面の周辺部を除く中央部の大部分におい 20 て、複数の画素領域がマトリックス状に配置されて表示 部を構成している。

【0019】各画素領域における液晶は、それに対して 独立に生じる電界によって、光透過率が制御され、前記 バックライト2からの光が各画素領域の光透過率に応じ て透過することによって前記表示部に映像を形成するよ うになっている。

【0020】観察者はこの映像を目視することによっ て、該液晶表示パネル1の面に画素が構成されているよ うに認識することになる。

【0021】バックライト2は、液晶表示パネル1の背 面において少なくともその表示部を充分に被うようにし て配置された導光板2Aと、この導光板2Aの一側面に 配置された冷陰極線管2Bとから構成されている。

【0022】冷陰極線管2Bからの光Lは導光板2Aの 一側面に入射され、その後、他の側面等に反射しなが ら、最終的には液晶表示パネル1と対向する面から均一 に出射されるようになっている。

【0023】なお、導光板2Aの一側面に配置された冷 ·· 陰極線間2Bは、その光の一部が損失することなく該導 光板2Aの一側面に全て入射できるように、円弧形に形 成された反射板3によって被われるように構成されてい

【0024】図3は、前記液晶表示パネル1の構成を示 す平面図である。

【0025】同図において、液晶を介して互いに対向配 置される一対の透明基板のうちの一方の透明基板4があ り、この透明基板4の液晶側の面には、まず、図中x方 向に延在されy方向に並設されるゲート信号線5と、こ のゲート信号線5に絶縁されてy方向に延在されx方向 50 分を占めてたとえばITO (Indium-Tin-Oxide) からな

に並設されるドレイン信号線6とを備えている。

【0026】これらゲート信号線5とドレイン信号線6 とで囲まれる矩形状の領域がそれぞれ画素領域を構成 し、さらに、このマトリックス状に配置された各画素領 域の集合体で表示部を構成するようになっている。

【0027】そして、各画素領域には、ゲート信号線5 から供給された走査信号(電圧)によってオンされる薄 膜トランジスタTFTと、このオンされた薄膜トランジ スタTFTを介してドレイン信号線6から供給された映 像信号(電圧)が印加される画素電極(透明電極)7と が形成されている。また、前記薄膜トランジスタTFT をオンさせるゲート信号線5と異なる他の隣接するゲー ト信号線5と画素電極7との間には、付加容量素子Ca ddが形成され、前記薄膜トランジスタTFTがオフし た際に、該画素電極7に印加された映像信号を長く蓄積 できるようになっている。

【0028】一方、上述のような構成からなる透明基板 4とは異なる他の図示しない透明基板は、その面積が前 記透明基板4よりは若干小さく形成され、その周辺にお いて液晶を封入するためのスペーサ8を介して該透明基 板4と対向されて配置されている。この透明基板の液晶 側の面には各画素領域に共通な共通電極(透明電極)が 形成されている。これにより、この共通電極と映像信号 が印加された前記画素電極7との間に電界を生じせし め、これら各電極の間に介在された液晶の光透過率を変 化せしめるようになっている。

【0029】なお、各ゲート信号線5における走査信号 を供給する端子群5Aおよび各ドレイン信号線6におけ る映像信号を供給する端子群 6 Aのそれぞれは透明基板 4の周辺部に形成され、これら各端子群5A、6Aは他 の図示しない透明基板によって被われることなく、該透 明基板から露呈するようにして形成されている。

【0030】図4(a)は、図3における各画素領域 (たとえば図3の点線枠Aの領域)の具体的な構成を示 した平面図であり、図4 (b) は、同図 (a) のb-b線における断面を示した図である。

【0031】同図において、図中x方向に延在しy方向 に並設されるゲート信号線5がある。このゲート信号線 5は、その材料がA1あるいはその合金あるいはCrと Moの合金からなる金属層5aからなり、その側面には 透明基板4の側に末広がりとなるテーパが形成されてい る。このようなテーパを形成するのは、ゲート信号線5 における急峻な段差を軽減するためである。

【0032】そして、このゲート信号線5がA1あるい はその合金からなる場合は、このゲート信号線5の表面 (側面も含む) には陽極化成によって陽極化成膜 (A1 酸化膜) 5 b が形成されている。

【0033】また、このようなゲート信号線5と後述の ドレイン信号線6とで囲まれる領域において、その大部

30

5

る透明の画素電極7が形成されている。

【0034】さらに、前記ゲート信号線5および画素電 極7をも含んで透明基板4の表面にはたとえばシリコン 窒化膜からなる絶縁膜9が形成され、この絶縁膜9には 前記画素電極7の周辺部を除いた中央部の大部分を露呈 させる開口部が設けられている。

【0035】前記絶縁膜9の上面であって、薄膜トラン ジスタTFTを形成すべき領域には、半導体層10が形 成され、この半導体層10は、ゲート信号線5に対する 後述のドレイン信号線6との交差部にまで延在されて一 10 体的に形成されている。

【0036】そして、図中y方向に延在しかつx方向に 並設されてドレイン信号線6が形成され、このドレイン 信号線6はたとえばCrあるいはCrとMoの合金から なる材料で構成されている。

【0037】この場合のドレイン信号線6の材料として は、その上層にAlあるいはその合金からなる層を形成 した多層構造としてもよいことはいうまでもない。この ような構成とすることにより、ドレイン信号線6それ自 体の電気的抵抗を低減させることができるからである。

【0038】そして、ドレイン信号線6は、薄膜トラン ズタTFTの形成領域に形成された半導体層10上にま で延在する延在部が一体に形成され、その延在部におい て薄膜トランジスタTFTのドレイン電極6Aを構成し ている。

【0039】この場合、薄膜トランジスタTFTのソー ス電極7Aは、ドレイン電極6Aと同一材料からなり、 該ドレイン電極6A(ドレイン信号線6)の形成と同時 に形成されるようになっている。また、ソース電極 7 A は、絶縁膜9の開口部から露呈されている画素電極7の 一部にまで延在されて形成され、これにより、該画素電 極7との接続が図れるようになっている。

【0040】なお、薄膜トランジスタTFTにおけるド レイン電極 6 Aとソース電極 7 Aのそれぞれの半導体層 10との界面には高濃度の不純物がドープされたコンタ クト層が介在されており、このコンタクト層は以下に示 す手順で形成されるようになっている。

【0041】すなわち、半導体層10を透明基板4の全 域に形成した後、その表面の全域に高濃度の不純物をド ープし、さらに、該半導体層10を上述したパターンに 選択エッチングする。そして、ドレイン電極 6 Aおよび ソース電極7Aを形成した後に、これら各電極6A、7 Aをマスクとして、これら各電極6A、7Aから露呈さ れて形成されている高濃度の不純物がドープされた層を 選択エッチングする。

【0042】このように構成される薄膜トランジスタT FTは、半導体層10が重畳されるゲート信号線5の一 部がゲート電極を兼ね、その表面の陽極化成膜5bおよ びそれに積層される絶縁膜9がゲート絶縁膜を兼ねる、 いわゆるMIS型のトランジスタを構成するようになっ 50 れ照射されるバックライト2からの光は、各画素領域内

ている。

【0043】さらに、前記ドレイン信号線6と同一の材 料からなり、該ドレイン信号線6の形成と同時に形成さ れる付加容量素子Caddの一方の電極11が、ゲート 信号線5の一部に重畳され、かつ、絶縁膜9の開口部か ら露呈されている画素電極7の一部にまで延在され該画 素電極7と接続が図れて形成されている。この付加容量 素子Caddは、前記ゲート信号線5を他方の電極と し、その表面に形成された陽極化成膜5 b および絶縁膜 9を誘電体膜として構成されている。

6

【0044】そして、このように構成された透明基板4 の表面の全域には、たとえばシリコン窒化膜からなる保 護膜12が形成され、この保護膜12によってたとえば 薄膜トランジスタTFTへの液晶の直接的な接触等が回 避されるようになっている。

【0045】このように構成された液晶表示パネル1を 備える図2に示した液晶表示装置は、その図面の点線枠 Bの部分を拡大して示すと図1に示すようになってい る。

【0046】同図において、特徴的な部分は、液晶表示 パネル1を構成する一対の透明基板のうち、バックライ ト2 (導光板2A) の側に位置づけられる透明基板の該 導光板2Aの側の面に、各画素領域ごとに凸レンズ14 からなるマイクロレンズが形成されていることにある。

【0047】すなわち、この実施例では、バックライト 2の側に位置づけられる透明基板は、図3に示したよう に、膜膜トランジスタTFTが形成されている透明基板 4に対向配置される他の透明基板20となっており、こ の透明基板20の液晶側の面には、まず、いわゆるブラ ックマトリックスと称される遮光膜21が形成されてい る。

【0048】この遮光膜21は、画素領域の周辺を縁取 るようにして形成される格子状のパターンを有し、対向 する前記透明基板4に形成されたゲート信号線5および ドレイン信号線6の配置する個所に対応づけられてい

【0049】なお、この遮光膜21によって囲まれる各 画素領域は、カラーフィルタ22がその周辺を前記遮光 膜21に重畳されて形成され、この遮光膜21およびカ ラーフィルタ22を被ってたとえば合成樹脂からなる平 坦膜23が形成され、この平坦膜23の上面には共通電 極(透明電極) 24が形成されている。さらに、この共 通電極24の表面には図示していないが配向膜が形成さ れている。

【0050】前記凸レンズ14は、それぞれ各画素領域 に独立に形成され、隣接する他の凸レンズ14とは光学 的に画されて形成されている。

【0051】このような凸レンズ14が形成されている ことによって、液晶表示パネル1の各画素領域にそれぞ

に集光され、その集光された光はそのまま観察者側へ至ることになる。

【0052】このことは、各画素領域のいわゆる開口率の大小に拘らず、バックライトからの光を有効に利用できることを意味する。

【0053】したがって、実質的に開口率を大幅に向上 させたことと同様の効果を得ることができるようにな る。

【0054】なお、透明基板20の液晶側と反対側の面に被着される偏光板26は、これら凸レンズ14を被って形成されており、その透明基板20への被着個所は、この実施例では特に、該凸レンズ14が形成された表示部を回避し、その表示部の周辺部における透明基板20面に被着された構成となっている。

【0055】このようにする理由は、各凸レンズ14の間に接着材が充填されることによって該凸レンズ14の屈折率が小さくなりその集光度合いの劣化が生じるのを防止するためである。

【0056】次に、このような凸レンズ14の製造および偏光板26の配置について、以下、図5を用いて説明 20 をする。

【0057】<u>工程1. (図5 (a))</u>

液晶表示パネルを構成する一対の透明基板4、20を用 意する。

【0058】この場合、一対の透明基板4、20のそれぞれの主表面において、その中央部の大部分が表示部を構成する領域となり、その中央部を除く周辺部の領域は表示部として寄与できない部分となっている。

【0059】<u>工程2. (図5(b))</u>

透明基板20の各主表面のうちバックライト2の側の面 30 の全域に、光透過性の良好な合成樹脂 (レジスト)を均一な膜厚で塗布することによって合成樹脂膜14Aをする。

【0060】工程3. (図5 (c))

透明基板20に形成された合成樹脂膜14Aを、周知のフォトリソグラフィ技術を用いた選択エッチング方法により、所望のパターンに形成する。

【0061】この場合のパターンとしては、表示部を構成する領域において、各画素領域毎に島状に合成樹脂膜14Aが残存されるように形成する。この残存された島40状の合成樹脂膜14Aはその平面的形状として円形であることが最適である。しかし、その形状に限定されることはなく、たとえば矩形、あるいは他の形状をあってもよい。本発明の目的を達成するためのレンズの機能としてはそれで充分であるからである。

【0062】<u>工程4. (図5 (d))</u>

このように島状に形成された合成樹脂膜14Aのそれぞれに均一かつ最適な温度で熱処理を施す。

【0063】これにより、各合成樹脂膜14Aは適度に ばならないことから、これら名軟化し、その際の表面張力によってほぼ半球状の形状に 50 率が低減せざるを得なくなる。

なる。

【0064】その後、常温にまで温度を低下させることによって、各合成樹脂膜14Aは半球状の形状を保持しながら硬化し、それぞれ凸レンズ14としての機能を有するようになる。

8

【0065】工程5. (図5 (e))

各凸レンズ14が形成された透明基板20の表面に偏光板26を接着剤を介して被着させる。この場合、一対の透明基板20に対する偏光板26の被着領域は、各凸レンズ14が形成された表示部の領域を回避し、その周辺部における領域において被着させるようにする。

【0066】さらに、図1に示すように、液晶表示パネル1の観察側における透明基板4の観察側の面には偏光板27が被着され、また、この実施例では、特に、いわゆる位相差板30が配置されている。この位相差板30を配置させることによって、カラー表示における色ずれを防止することができるからである。

【0067】すなわち、本実施例の構成のように、前記 凸レンズ14を配置させることによって、観察者は、バックライト2から液晶を介して斜めに来る光を感知せざるを得なくなることは否めない。この場合、観察者はカラー表示における色ずれを認識するようになってしまうことになる。このため、上述のような位相差板30を配置させることによって、斜めに来る光の位相を変化させ、これによって正常な色に戻して観察者に認識させるように構成している。

【0068】 〔実施例2〕 実施例1に示した液晶表示装置は、いわゆる縦電界方式と称される液晶表示パネルを用いた構成について説明したものである。ここで、縦電界方式とは、一対の透明基板に介在された液晶に該透明基板とほぼ垂直方向に電界を発生せしめることによって、該液晶の光透過率を制御するものをいう。

【0069】そして、このような縦電界方式と対比されるものとして、いわゆる横電界方式の液晶表示パネルが知られるに至っている。一対の透明基板に介在された液晶に該透明基板とほぼ平行な方向に電界を発生せしめることによって、該液晶の光透過率を制御するものである。

【0070】このような横電界方式の液晶表示パネルは、いわゆる広視野角特性に優れたものとして知られ、液晶表示パネルの垂直方向に対してかなり大きな角度の方向から表示部を観察しても殆ど色ずれを起すことなく画像を明瞭に認識できるようになっている。

【0071】この実施例では、このような横電界方式の 液晶表示パネルに本発明を適用したものである。

【0072】横電界方式の液晶表示パネルは、その画素 領域において、原則として一方の透明基板の側に2個の 電極(透明でなくともよい)を並設させて形成しなけれ ばならないことから、これら各電極の存在によって開口 率が低減せざるを得なくなる。 【0073】また、上述したように、広視野角特性に優れたものであることから、バックライトからの光は、液晶表示パネルを通過した際には、観察者側に広視野角で進行する構成とすることが期待される。

【0074】このことから、横電界方式の液晶表示パネルにおいて、そのバックライト側の透明基板の該液晶とは反対の側の面に、その各画素領域毎に凸レンズを形成することによって、小さな開口率による弊害を除去できるとともに、広視野角特性をさらに向上させることができるようになる。

【0075】次に、図6を用いて、横電界方式の液晶表示パネルの具体的構成について、以下説明をする。なお、実施例1にて用いた符号と同一の符号はそれらと同一の機能を有するものとして示している。

【0076】同図は、液晶を介して互いに対向配置される一対の透明基板のうち一方の透明基板4の一画素領域における液晶側の構成を示す平面図である。

【0077】同図において、まず、図中x方向に延在し y方向に並設されたゲート信号線5を備えている。さら に、これら各ゲート信号線5に隣接されて基準信号線4 0がそれぞれ該ゲート線5に対して同じ側(同図では下 側)に配列されて配置されている。

【0078】この場合、一方のゲート信号線5と比較的 広い距離を介して対向する基準信号線40と、後述する ドレイン信号線6(y方向に延在しx方向に並設する) とで囲まれる矩形の領域によって一画素領域が形成され るようになっている。

【0079】ここで、前記基準信号線40は、画素領域に延在する3本のストライブ状の基準電極40Aと一体に形成されている。これら各基準電極40Aは画素領域 30内で当間隔に配置され、両脇に位置づけられる基準電極40Aは後述するドレイン信号線6と近接されて形成されている。

【0080】そして、前記ゲート信号線5と基準信号線40(基準電極40A)とを被って透明基板4の全域には絶縁膜9が形成され、この絶縁膜9の上面には、薄膜トランジスタTFT、ドレイン信号線6、画素電極41が形成されている。

【0081】ドレイン信号線6は図中y方向に延在しかつx方向に並設されて形成され、これら互いに隣接するドレイン信号線6と前記ゲート信号線5および基準信号線40とで囲まれる領域で画素領域を構成することは前述したとおりである。

【0082】薄膜トランジスタTFTは、画素領域側に 位置づけられているゲート信号線5の一部に重畳される ように形成され、その構成は実施例1に示した薄膜トラ ンジスタとほぼ同様となっている。

【0083】薄膜トランジスタTFTのドレイン電極6 ける平面図およびその一Aは、前記ドレイン信号線6と同材料からなり、該ドレ 【図5】本発明による液イン信号線6の形成の際に同時に形成されるようになっ 50 例を示す工程図である。

ている。

【0084】また、画素電極41は、その一部が基準信号線40に重畳され画素領域内において基準電極40Aのそれぞれの間を走行するほぼコ字状のパターンによって形成されてる。

10

【0085】そして、その一端はそのまま延在されて薄膜トランジスタTFTのソース電極41Aを構成するようになっている。

【0086】また、画素電極41の基準信号線40に重 畳される領域は、該画素電極41と基準信号線40との 間に形成された付加容量素子Caddを構成するように なっている。

【0087】そして、このように加工された透明基板の 表面には保護膜12が形成され、この保護膜12の表面 には配向膜13が形成されている。

【0088】図7は、図6のVII-VII線における断面図で、液晶を介して対向配置される他の透明基板とともに示している。

【0089】同図から明らかなように、画素電極41と 基準電極40Aとの間に発生する電界Eは、液晶LC内 にて透明基板4と平行に発生し、液晶LCはこの電界E によってその光透過率が制御されるようになっている。

【0090】そして、このような液晶表示パネルにおいても、たとえば透明基板4側にバックライトが配置される場合には、その透明基板4の液晶とは反対側の面において、その画素領域ごとに凸レンズ14が形成されている。

【0091】上述したそれぞれの液晶表示装置は、各画素領域ごとに薄膜トランジスタを備えたアクティブ・マトリックス型のものについて説明したものであるが、このような液晶表示装置に限定されることはないことはいうまでもない。 薄膜トランジスタを備えていないいわゆるSTN型の液晶表示装置等にも適用できることはいうまでもない。

[0092]

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、本発明による液晶表示装置によれば、微細加工の限界等にも拘らず、実質的に開口率を大幅に向上させたことと同様の効果を得ることができるようになる。

40 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す要 部断面図である。

【図2】本発明による液晶表示装置の概略を示す側面図である。

【図3】本発明による液晶表示装置に用いられる液晶表示パネルの一実施例を示す平面図である。

【図4】図3に示した液晶表示パネルの各画素領域における平面図およびその一部の断面図である。

【図5】本発明による液晶表示装置の製造方法の一実施 例を示す工程図である。

【図6】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図である。

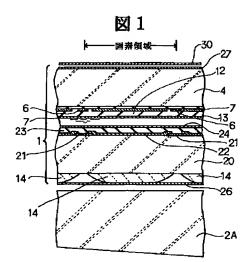
【図7】図6のVII-VII線における断面図である。

【符号の説明】

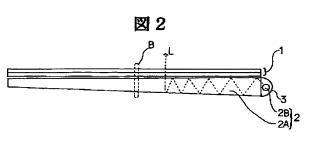
4……透明基板、14……凸レンズ、14A……合成樹

12

【図1】



【図2】



【図4】

